固体物理作业

郑晓旸 202111030007

2025年6月11日

问题与解答

问题 4.1

根据 $k = \pm \frac{\pi}{a}$ 状态简并微扰结果,求出与 E_- 及 E_+ 相应的波函数 ψ_- 及 ψ_+ 。说明它们都代表驻波,并比较两个电子云分布(即 $|\psi|^2$)说明能隙的来源(假设 $V_n = V_n^*$)。

解答

令 $k = \frac{\pi}{a}$, $k' = -\frac{\pi}{a}$, 简并微扰波函数为 $\psi = A\psi_{k'}^{0}(x) + B\psi_{k'}^{0}(x)$ 。

$$\begin{cases} [E^{0}(k) - E]A + V_{n}B = 0\\ V_{n}^{*}A + [E^{0}(k') - E]B = 0 \end{cases}$$

取 $E = E_+$,带入上式,其中 $E_+ = E^0(k) + |V_n|$ 。 V(x) < 0, $V_n < 0$,从上式得到 B = -A,于是

$$\psi_{+} = A[\psi_{k}^{0}(x) - \psi_{k'}^{0}(x)] = \frac{A}{\sqrt{L}} \left[e^{i\frac{\pi}{a}x} - e^{-i\frac{\pi}{a}x} \right] = \frac{2A}{\sqrt{L}} \sin\frac{\pi}{a}x$$

取 $E = E_-$, $E_- = E^0(k) - |V_n|$, $V_n^* A = -V_n B$, 得到 A = B。

$$\psi_{-} = A[\psi_{k}^{0}(x) + \psi_{k'}^{0}(x)] = \frac{A}{\sqrt{L}} \left[e^{i\frac{\pi}{a}x} + e^{-i\frac{\pi}{a}x} \right] = \frac{2A}{\sqrt{L}} \cos \frac{\pi}{a} x$$

由教材可知, ψ_+ 及 ψ_- 均为驻波。在驻波状态下,电子的平均速度 v(k) 为零。产生驻波因为电子波矢 $k=\frac{\pi}{a}$ 时,电子波的波长 $\lambda=\frac{2\pi}{k}=2a$,恰好满足布拉格反射条件,这时电子波发生全反射,并与反射波形成驻波。由于两驻波的电子分布不同,所以对应不同本征能量。

问题 4.2

写出在一维近自由电子近似,第 n 个能带(n=1,2,3)中,简约波矢 $k=\frac{\pi}{2a}$ 的 0级波函数。

解答

$$\psi_k^*(x) = \frac{1}{\sqrt{L}} e^{jkx} = \frac{1}{\sqrt{L}} e^{j\frac{\pi}{2a}x} e^{i\frac{2\pi}{a}mx} = \frac{1}{\sqrt{L}} e^{i\frac{\pi}{2a}x} \cdot e^{i\frac{2\pi}{a}mx} = \frac{1}{\sqrt{L}} e^{i\frac{2\pi}{a}(m+\frac{1}{4})x}$$

第一能带: $m \cdot \frac{\pi}{2a} = 0$, m = 0, $\psi_k^*(x) = \frac{1}{\sqrt{L}} e^{i\frac{\pi}{2a}x}$

第二能带: b = b' 则 $b' \to b$, $m \cdot \frac{2\pi}{a} = -\frac{2\pi}{a}$, 即 m = -1, $\psi_k^*(x) = \frac{1}{\sqrt{L}} e^{i\frac{3\pi}{2a}x}$ 第三能带: $c' \to c$, $m \cdot \frac{2\pi}{a} = \frac{2\pi}{a}$, 即 m = 1, $\psi_k^*(x) = \frac{1}{\sqrt{L}} e^{i\frac{\pi}{2a}x} \cdot e^{i\frac{2\pi}{a}x} = \frac{1}{\sqrt{L}} e^{i\frac{5\pi}{2a}x}$

问题 4.3

电子在周期场中的势能:

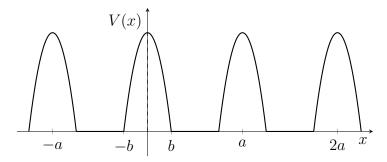
$$V(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}m\omega^{2}[b^{2} - (x - na)^{2}], & \pm na - b \le x \le na + b \\ 0, & \pm (n - 1)a + b \le x \le na - b \end{cases}$$

其中 a=4b, ω 是常数。

(1) 试图画出势能曲线, 并求其平均值。(2) 用近自由电子近似模型求出晶体的第一 个及第二个带隙宽度。

解答

(1) 题目设势能曲线如下所示:



(2) 势的平均值:由图可见,V(x) 是一个以a 为周期的周期函数,所以

$$\overline{V(x)} = \frac{1}{L} \int V(x) dx = \frac{1}{a} \int_0^a V(x) dx = \frac{1}{a} \int V(x) dx$$

2

题目设 a=4b,故积分上限应为 a-b=3b,但由于在 [b,3b] 区间内 V(x)=0,故只需在 [-b,b] 区间内积分。这时,n=0,于是

$$\overline{V} = \frac{1}{a} \int_{-b}^{b} V(x) dx = \frac{m\omega^2}{2a} \int_{-b}^{b} (b^2 - x^2) dx = \frac{m\omega^2}{2a} \left[b^2 x - \frac{1}{3} x^3 \right]_{-b}^{b} = \frac{1}{6} m\omega^2 b^2$$

(3) 势能在 [-2b, 2b] 区间是个偶函数,可以展开成傅里叶级数

$$V(x) = V_0 + \sum_{m = -\infty}^{\infty} V_m \cos \frac{m\pi}{2b} x, \quad V_m = \frac{2}{2b} \int_0^{2b} V(x) \cos \frac{m\pi}{2b} x dx = \frac{1}{b} \int_0^b V(x) \cos \frac{m\pi}{2b} x dx$$

第一个禁带宽度 $E_{g1}=2|V_1|$, 以 m=1 代入上式,

$$E_{g1} = \frac{m\omega^2}{b} \int_0^b (b^2 - x^2) \cos\frac{\pi x}{2b} dx$$

利用积分公式 $\int u^2 \cos mu du = \frac{u}{m^2} (mu \sin mu + 2 \cos mu) - \frac{2}{m^3} \sin mu$ 得

$$E_{g1} = \frac{16m\omega^2}{\pi^3}b^2$$

第二个禁带宽度 $E_{g2}=2|V_2|$,以 m=2 代入上式,代入上式

$$E_{g2} = \frac{m\omega^2}{b} \int_0^b (b^2 - x^2) \cos\frac{\pi x}{b} dx$$

再次利用积分公式有

$$E_{g2} = \frac{2m\omega^2}{\pi^2}b^2$$

问题 4.12

设有二维正方晶格,晶体势为 $U(x,y) = -4U\cos\left(\frac{2\pi x}{a}\right)\cos\left(\frac{2\pi y}{a}\right)$ 。用近自由电子近似的微扰论,近似求出布里渊区顶角 $\left(\frac{\pi}{a},\frac{\pi}{a}\right)$ 处的能隙。

解答

以 $\hat{\mathbf{i}},\hat{\mathbf{j}}$ 表示位置矢量的单位矢量,以 $\hat{\mathbf{b}}_1,\hat{\mathbf{b}}_2$ 表示倒易矢量的单位矢量,则有, $\mathbf{r}=x\hat{\mathbf{i}}+y\hat{\mathbf{j}},\ \mathbf{G}=G_1\hat{\mathbf{b}}_1+G_2\hat{\mathbf{b}}_2=\frac{2\pi}{a}(g_1\hat{\mathbf{b}}_1+g_2\hat{\mathbf{b}}_2),\ g_1,g_2$ 为整数。晶体势能 $U(x,y)=-4U\cos\left(\frac{2\pi x}{a}\right)\cos\left(\frac{2\pi y}{a}\right)$ 。可以写成傅里叶级数形式:

$$U(\mathbf{r}) = -U\left(e^{i\frac{2\pi}{a}x} + e^{-i\frac{2\pi}{a}x}\right)\left(e^{i\frac{2\pi}{a}y} + e^{-i\frac{2\pi}{a}y}\right) = \sum_{\mathbf{G}} U_{\mathbf{G}}e^{i\mathbf{G}\cdot\mathbf{r}}$$

其中非零的傅里叶系数为 $U_{\mathbf{G}(1,1)} = U_{\mathbf{G}(-1,-1)} = U_{\mathbf{G}(1,-1)} = U_{\mathbf{G}(-1,1)} = -U_{\mathbf{G}}$ (注: 这里 $\mathbf{G}(g_1,g_2)$ 表示 $g_1\frac{2\pi}{a}\hat{\mathbf{b}}_1 + g_2\frac{2\pi}{a}\hat{\mathbf{b}}_2$ 对应的倒格矢,其系数为 $U_{\mathbf{G}}$ 。)基本方程为

$$(\lambda_{\mathbf{K}} - \epsilon)C(\mathbf{K}) + \sum_{\mathbf{G}} U_{\mathbf{G}}C(\mathbf{K} - \mathbf{G}) = 0$$

其中 $\lambda_{\mathbf{K}} = \frac{\hbar^2 K^2}{2m}$ 。考虑布里渊区顶角 $\mathbf{K} = (\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a})$ 。这个波矢与 $\mathbf{K}' = \mathbf{K} - \mathbf{G}(1,1) = (\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a}) - (\frac{2\pi}{a}, \frac{2\pi}{a}) = (-\frac{\pi}{a}, -\frac{\pi}{a}) = -\mathbf{K}$ 是简并的(在空晶格近似下, $\lambda_{\mathbf{K}} = \lambda_{-\mathbf{K}}$)。根据近自由电子近似的微扰论(特别是二能级近似),我们主要考虑这两个状态的耦合。其他 $\mathbf{K} - \mathbf{G}$ 的能量 $\lambda_{\mathbf{K} - \mathbf{G}}$ 与 $\lambda_{\mathbf{K}}$ 相差较大。与 $C(\mathbf{K})$ 耦合的主要项是 $U_{\mathbf{G}(1,1)}C(\mathbf{K} - \mathbf{G}(1,1)) = U_{\mathbf{G}(1,1)}C(-\mathbf{K})$ 。与 $C(-\mathbf{K})$ 耦合的主要项是 $U_{\mathbf{G}(-1,-1)}C(-\mathbf{K} - \mathbf{G}(-1,-1)) = U_{\mathbf{G}(-1,-1)}C(\mathbf{K})$ 。注意 $U_{\mathbf{G}(1,1)} = U_{\mathbf{G}(-1,-1)} = -U$ 。因此,方程组简化为:

$$\begin{cases} (\lambda_{\mathbf{K}} - \epsilon)C(\mathbf{K}) + U_{\mathbf{G}(1,1)}C(-\mathbf{K}) = 0\\ (\lambda_{-\mathbf{K}} - \epsilon)C(-\mathbf{K}) + U_{\mathbf{G}(-1,-1)}C(\mathbf{K}) = 0 \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} (\lambda_{\mathbf{K}} - \epsilon)C(\mathbf{K}) - UC(-\mathbf{K}) = 0 \\ (\lambda_{\mathbf{K}} - \epsilon)C(-\mathbf{K}) - UC(\mathbf{K}) = 0 \end{cases}$$

该线性方程组有非零解的条件是系数行列式为零:

$$\begin{vmatrix} \lambda_{\mathbf{K}} - \epsilon & -U \\ -U & \lambda_{\mathbf{K}} - \epsilon \end{vmatrix} = 0$$

其中

$$\lambda_{\mathbf{K}} = \frac{\hbar^2 |\mathbf{K}|^2}{2m} = \frac{\hbar^2}{2m} \left[\left(\frac{\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{\pi}{a}\right)^2 \right] = \frac{\hbar^2 \pi^2}{ma^2}$$

(注:图片中 λ 的计算步骤有歧义,这里给出详细过程)行列式展开得到:

$$(\lambda_{\mathbf{K}} - \epsilon)^2 - U^2 = 0$$

解得能量本征值:

$$\epsilon = \lambda_{\mathbf{K}} \pm U = \frac{\hbar^2 \pi^2}{ma^2} \pm U$$

所以在布里渊区顶角 $\left(-\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a}\right)$ 处的两个能级为 $\epsilon_{+} = \frac{\hbar^{2}\pi^{2}}{ma^{2}} + U$ 和 $\epsilon_{-} = \frac{\hbar^{2}\pi^{2}}{ma^{2}} - U$ 。能隙宽度为:

$$\Delta \epsilon = \epsilon_+ - \epsilon_- = 2U$$

问题 5.1

设一维晶体的电子能带可以写成

$$E(k) = \frac{\hbar^2}{ma^2} \left(-\frac{7}{8} \cos ka + \frac{1}{8} \cos 2ka \right)$$

其中 a 为晶格常数, 计算:

- 1. 能带的宽度
- 2. 电子在波矢 k 的状态时的速度
- 3. 能带底部和能带顶部电子的有效质量

解答

1. 能带的宽度的计算

$$E(k) = \frac{\hbar^2}{ma^2} \left(-\frac{7}{8}\cos ka + \frac{1}{8}\cos 2ka \right)$$

能带底部 k=0

$$E(0) = \frac{\hbar^2}{ma^2} \left(-\frac{7}{8} + \frac{1}{8} \right) = -\frac{3}{4} \frac{\hbar^2}{ma^2}$$

能带顶部 $k = \frac{\pi}{a}$

$$E\left(\frac{\pi}{a}\right) = \frac{\hbar^2}{ma^2} \left(-\frac{7}{8}\cos \pi + \frac{1}{8}\cos 2\pi \right) = \frac{\hbar^2}{ma^2} \left(\frac{7}{8} + \frac{1}{8} \right) = \frac{\hbar^2}{ma^2}$$

能带宽度

$$\Delta E = E\left(\frac{\pi}{a}\right) - E(0) = \frac{\hbar^2}{ma^2} - \left(-\frac{3}{4}\frac{\hbar^2}{ma^2}\right) = \frac{7}{4}\frac{\hbar^2}{ma^2}$$

2. 电子在波矢 k 的状态时的速度

$$E(k) = \frac{\hbar^2}{ma^2} \left(-\frac{7}{8}\cos ka + \frac{1}{8}\cos 2ka \right)$$

电子的速度

$$v(k) = \frac{1}{\hbar} \frac{dE(k)}{dk}$$

$$v(k) = \frac{1}{\hbar} \frac{\hbar^2}{ma^2} \left(\frac{7}{8} a \sin ka - \frac{1}{8} 2a \sin 2ka \right) = \frac{\hbar}{ma} \left(\frac{7}{8} \sin ka - \frac{1}{4} \sin 2ka \right)$$

3. 能带底部和能带顶部电子的有效质量

$$E(k) = \frac{\hbar^2}{ma^2} \left(-\frac{7}{8} \cos ka + \frac{1}{8} \cos 2ka \right)$$

电子的有效质量

$$m^* = \hbar^2 / \frac{\partial^2 E}{\partial k^2}$$

$$\frac{\partial^2 E}{\partial k^2} = \frac{\hbar^2}{ma^2} \left(-\frac{7}{8} (-a^2) \cos ka + \frac{1}{8} (-4a^2) \cos 2ka \right) = \frac{\hbar^2}{m} \left(\frac{7}{8} \cos ka - \frac{1}{2} \cos 2ka \right)$$

$$m^* = \frac{\hbar^2}{\frac{\hbar^2}{m} \left(\frac{7}{8}\cos ka - \frac{1}{2}\cos 2ka\right)} = \frac{m}{\frac{7}{8}\cos ka - \frac{1}{2}\cos 2ka}$$

能带底部 k=0

$$m^* = \frac{m}{\frac{7}{8} - \frac{1}{2}} = \frac{m}{\frac{3}{8}} = \frac{8}{3}m$$

能带顶部 $k = \frac{\pi}{a}$

$$m^* = \frac{m}{\frac{7}{8}\cos\pi - \frac{1}{2}\cos 2\pi} = \frac{m}{-\frac{7}{8} - \frac{1}{2}} = \frac{m}{-\frac{11}{8}} = -\frac{8}{11}m$$